

Silicon Diode

LL4148

75V / 150mA

DATASHEET

OEM – Telefunken

Source: Telefunken Databook 1985

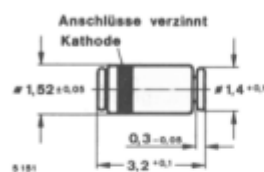
Telefunken

Diode LL4148

Datasheet

LL 4148**Silizium-Epitaxial-Planar-Diode****Anwendungen:** Extrem schnelle Schalter**Besondere Merkmale:**

- Elektrische Daten entsprechen denen des Typs 1N 4148

Abmessungen in mm

SOD 80
MiniMELF
Gewicht max. 0,1 g

Bestempelung: JEDEC Farbcodierung**Absolute Grenzwerte**

Periodische Spitzensperrspannung	U_{RRM}	100	V
Sperrspannung	U_R	75	V
Stoßdurchlaßstrom $t_p < 1 \mu s$	I_{FSM}	2	A
Periodischer Durchlaßspitzenstrom	I_{FRM}	450	mA
Durchlaßstrom, Mittelwert	I_{FAV}	150	mA
Verlustleistung	P_{tot}	350	mW
Sperrschichttemperatur	T_j	200	°C
Lagerungstemperaturbereich	T_{stg}	- 55.... + 200	°C

LL 4148

Wärmewiderstand		Min.	Typ.	Max.	
auf Leiterplatte					
50 mm x 50 mm x 1,6 mm	R_{thJA}			500	K/W
Kenngrößen					
$T_I = 25\text{ °C}$, falls nicht anders angegeben					
Durchlaßspannung					
$I_F = 50\text{ mA}$	U_F			1	V
Sperrstrom					
$U_R = 20\text{ V}$	I_R			25	nA
$U_R = 20\text{ V}$, $T_I = 150\text{ °C}$	I_R			50	μA
$U_R = 75\text{ V}$	I_R			5	μA
Durchbruchspannung					
$I_R = 100\text{ μA}$	U_{BR}	100			V
Diodenkapazität					
$U_R = 0$, $f = 1\text{ MHz}$, $U_{HF} = 50\text{ mV}$	C_D		2	4	pF
Richtwirkungsgrad					
$U_{HF} = 2\text{ V}$, $f = 100\text{ MHz}$		45			%
Rückwärtserholzeit					
$I_F = I_R = 10\text{ mA}$, $i_R = 1\text{ mA}$	t_{rr}			8	ns